

2000 в линейном и 10^4 — 10^6 в матричном ПЗС; площадь пластины $\sim 1 \text{ см}^2$. Под крайними электродами каждой строки изготавливают p — n -переходы, предназначенные для ввода — вывода порций зарядов (зарядовых пакетов) электрич. способом (инжекция p — n -переходом). При фотоэлектрич. вводе зарядовых пакетов ПЗС освещают с фронтальной или тыльной стороны. При фронтальном освещении во избежание затеняющего действия электродов алюминий обычно заменяют плёнками сильнолигиров. поликристаллич. кремния (поликремния), прозрачного в видимой и ближней ИК-области спектра.

Принцип действия ПЗС на примере фрагмента строки ФПЗС, управляемой трёхтактовой (трёхфазной) схемой, иллюстрируется на рис. 2. В течение такта I (восприятие, накопление и хранение видеинформации) к



Рис. 1. Схема работы трёхфазного прибора с зарядовой связью — сдвигового регистра.

всякому пакету пропорциональна экспозиции поверхности вблизи данного электрода. В хорошо сформированных МДП-структурках образующиеся заряды вблизи электродов могут относительно долго сохраняться, однако постепенно вследствие генерации носителей зарядов примесными центрами, дефектами в объёме или на границе раздела (температурный ток) эти заряды будут накапливаться в потенц. ямах, пока не превысят сигнальные заряды и даже полностью заполнят ямы.

Во время такта II (перенос зарядов) к электродам 2, 5, 8 и т. д. прикладывается т. н. напряжение считывания, U_c , более высокое, чем напряжение хранения U_{xp} . Поэтому под электродами 2, 5 и 8 возникают более глубокие потенц. ямы, чем под электронами 1, 4 и 7, и вследствие близости электродов 1 и 2, 4 и 5, 7 и 8 барьеры между ними исчезают и электроны перетекают в соседние, более глубокие потенц. ямы.

Во время такта III напряжение на электродах 2, 5, 8 снижается до U_{xp} , а с электродов 1, 4, 7 снимается. Т. о. осуществляется перенос всех зарядовых пакетов вдоль строки ПЗС вправо на один шаг, равный расстоянию между соседними электродами.

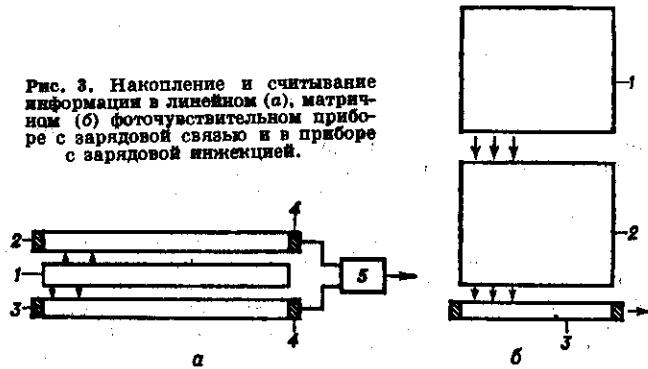
Во всё время работы на электродах, непосредственно не подключённых к потенциалам U_{xp} или U_c , поддерживается небольшое напряжение смещения U_{sh} (1—3 В), обеспечивающее обединение носителей заряда всей поверхности полупроводника и ослабление на ней рекомбинац. эффектов.

Повторяя процесс коммутации напряжений многократно, выводят через крайний p — n -переход последовательно все зарядовые пакеты, возбуждённые, напр., светом в строке. При этом в выходной цепи возникают импульсы напряжения, пропорциональные величине заряда данного пакета. Картина освещённости трансформируется в поверхностный зарядовый рельеф, к-рый после продвижения вдоль всей строки преобразуется в последовательность электрич. импульсов. Чем больше

число элементов в строке или матрице (число элементов разложения), тем точнее воспринимается изображение.

При небольшом числе переносов увеличиваются рекомбинац. потери, происходит неполная передача зарядового пакета от одного электрода к соседнему и усиливаются обусловленные этим искажением информации. Чтобы избежать искажений накопленного видеосигнала из-за продолжающегося во время переноса освещения, на кристалле ФПЗС создаёт пространственно разделённые области восприятия — накопления и хранения — считывания, причём в первых обеспечивают макс. фоточувствительность, а вторые, наоборот, экранируют от света. В линейном ФПЗС (рис. 3, а) заряды, накопленные в строке 1 за один цикл, передаются в регистр 2 (из чётных элементов) и в регистр 3 (из

Рис. 3. Накопление и считывание информации в линейном (а), матричном (б) фоточувствительном приборе с зарядовой связью и в приборе с зарядовой инъекцией.



нечётных). В то время, как по этим регистрам информация передаётся через выход 4 в схему объединения сигналов 5, в строке 1 накапливается новый видеокадр. В ФПЗС с кадровым переносом (рис. 3, б) информация, воспринятая матрицей накопления 1, быстро «сбрасывается» в матрицу хранения 2, из к-рой последовательно считывается ПЗС-регистром 3; в это же время матрица 1 накапливает новый кадр.

Оси. параметры ПЗС: амплитуды управляющих импульсов (U_{xp} , $U_c \approx 5$ — 20 В), относит. потери заряда при одном переносе ($e \sim 10^{-3}$ — 10^{-5}), макс. тактовая частота ($f_{\text{такт}} = 10$ — 100 МГц), макс. и мин. плотности зарядового пакета (Q_n , макс. ≈ 50 нКл/см²; Q_n , мин. ≈ 50 пКл/см²), динамич. диапазон ($D = 20 \lg Q_{n,\text{макс.}}/Q_{n,\text{мин.}}$, мин. ≈ 60 — 80 дБ), плотность темнового тока ($I_t = 10^{-10}$ — 10^{-9} А/см²). Для характеристики ФПЗС кроме перечисленных выше параметров указываются спектральный диапазон ($\Delta\lambda = 0,4$ — $1,1$ мкм), фоточувствительность ($S_F = 0,1$ — $0,5$ А/Вт), макс. и мин. экспозиции ($H_{\text{макс.}} \leq 300$ нДж/см², $H_{\text{мин.}} \geq 300$ пДж/см²), разрешающая способность ($r = 10$ — 50 линий/мм). Кроме ПЗС простейшей структуры (рис. 1) получили распространение и др. их разновидности, в частности приборы с поликремниевыми перекрывающимися электродами (рис. 4, а), в к-рых обеспечиваются активное фото воздействие на всю поверхность полупроводника и малый зазор между электродами, и приборы с асимметрией приповерхностных свойств (напр., слоем диэлектрика перем. толщины — рис. 4, б), работающие в двухтактовом режиме. Принципиально отлична структура ПЗС с объёмным каналом (рис. 4, в), образованным диффузией примесей. Накопление, хранение, перенос заряда происходят в объёме полупроводника, где меньше, чем на поверхности, рекомбинац. центров и выше подвижность носителей. Следствием этого является увеличение на порядок значения $f_{\text{такт}}$ и уменьшение e по сравнению со всеми разновидностями ПЗС с поверхностным каналом.

Для восприятия цветных изображений используют один из двух способов: разделение оптич. потока с помощью призмы на красный, зелёный, синий, восприятие каждого из них специальным ФПЗС — кристаллом,